

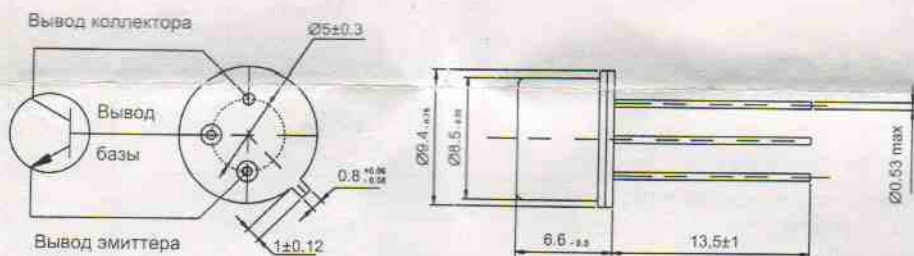


Транзистор 2Т630А, 2Т630Б

Этикетка

1. Общие сведения.

Кремниевые планарные n-p-n транзисторы типов 2Т630А, 2Т630Б в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.



Масса не более 1,45 г.

2. Основные технические данные.

Электрические параметры при температуре $t_{\text{ОКР}}=(25\pm 10)^{\circ}\text{C}$.

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		Не менее	Не более
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером 2Т630А 2Т630Б ($U_{\text{КЭ}}=10\text{В}$, $I_{\text{К}}=150\text{мА}$)	$h_{21Э}$	40 80	120 240
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА 2Т630А, 2Т630Б ($U_{\text{КЭ}}=90\text{В}$, $R_{\text{БЭ}}\leq 3\text{кОм}$)	$I_{\text{КЭР}}$		1
Обратный ток эмиттера, мкА 2Т630А, 2Т630Б ($U_{\text{ЭБ}}=5\text{В}$)	$I_{\text{ЭБО}}$		0.1
Граничное напряжение, В 2Т630А 2Т630Б ($I_{\text{Э}}=30\text{мА}$, $t_{\text{У}}\leq 100\text{мкс}\pm 10\%$, $Q\geq 200$)	$U_{\text{КЭОГР}}$	90 80	
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В 2Т630А, 2Т630Б ($R_{\text{БЭ}}=3\text{кОм}$, $I_{\text{К}}=100\text{мкА}$)	$U_{\text{КЭРОПРОБ}}$	120	
Пробивное напряжение эмиттер-база, В 2Т630А, 2Т630Б ($I_{\text{Э}}=100\text{мкА}$)	$U_{\text{ЭБОПРОБ}}$	7	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В 2Т630А, 2Т630Б ($I_{\text{К}}=150\text{мА}$, $I_{\text{Б}}=15\text{мА}$)	$U_{\text{КЭНАС}}$		0.3
Напряжение насыщения база-эмиттер, В 2Т630А, 2Т630Б ($I_{\text{К}}=150\text{мА}$, $I_{\text{Б}}=15\text{мА}$)	$U_{\text{БЭНАС}}$		1.1

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. приборов.

3. Сведения о приемке.

Транзисторы 2Т630А, 2Т630Б соответствуют техническим условиям ЮФЗ.365.043ТУ

Штамп ОТК



Штамп ПЗ

